

## Сведения о научном руководителе

по диссертации Обухова Сергея Владимировича

«Ab initio теория электрон-фононных процессов в полупроводниках кристаллах» по специальности 01.04.10 – Физика полупроводников на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Наименование организации, дата и номер приказа о назначении научным руководителем	Приказ по Томскому государственному Педагогическому университету от 16.10.2007 г., № 48/А
Фамилия, имя, отчество	Тютюрев Валерий Григорьевич
Гражданство	гражданин Российской Федерации
Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	доктор физико-математических наук, 01.04.10 - «Физика полупроводников»
Ученое звание (по какой кафедре / по какой специальности)	Профессор по кафедре общей физики
<b>Место работы</b>	
Почтовый индекс, адрес, телефон, web-сайт, электронный адрес организации	634041. г. Томск, ул. Киевская 60, Тел. (382-2) 521751, <a href="http://tspu.edu.ru">http://tspu.edu.ru</a> , e mail: <a href="mailto:rector@tspu.edu.ru">rector@tspu.edu.ru</a>
Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный педагогический университет»
Наименование подразделения	кафедра общей физики
должность	заведующий кафедрой общей физики
<b>Список основных публикаций научного руководителя по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)</b>	
1. Tyuterev V. G. Relaxation of highly excited carriers in wide-gap semiconductors / V. G. Tyuterev, V. P. Zhukov, P. M. Echenique and E. V. Chulkov // J. Phys.: Condens. Matter. - 2015. - Vol. 27. - P. 025801.	
2. Tyuterev V. Electron-Phonon Interaction in Short-Period (GaAs) <sub>m</sub> (AlAs) <sub>n</sub> (001) Superlattices / S. N. Grinyaev, L. N. Nikitina and V. G. Tyuterev // Semiconductors. - 2014. - Vol. 48, N 3. - P. 320-331.	
3. Tyuterev V. Ab initio study of the effects of pressure and strain on electron-phonon coupling in IV and III-V semiconductors / J. Sjakste, N. Vast, H. Kirit, S. Obukhov, V. Tyuterev // Physica Status Solidi (b) -2013. - Vol. 250, N 4. - P. 716-720.	
4. Tyuterev V. G. Electron-phonon relaxation and excited electron distribution in zinc oxide and anatase / V.P.Zhukov, V.G.Tyuterev, E.V.Chulkov // J. Phys.: Condens. Matter. - 2012. - Vol.24. - P.405802.	
5. Tyuterev V. G On the radiationless decay of a direct exciton in an indirect gap semiconductor / V. G. Tyuterev, S. V. Obukhov, Tomsk State Pedagogical University Bulletin. - 2011. - N 8(110). - P. 49-52.	
6. Tyuterev V. G Intervalley electron-phonon scattering in ultra-thin (GaAs) <sub>m</sub> (AlAs) <sub>n</sub> (001) superlattices / S. N. Grinyaev, L. N. Nikitina, V. G. Tyuterev //	

Advances in Materials Science Research.Nova Science, Ed: Maryann C. Wythers. – 2011. - Vol. 2, Ch. 9. - P.155-178.
7. Tyuterev V. G. Ab initio calculation of electron-phonon scattering time in germanium / V. G. Tyuterev , S. V. Obukhov, N. Vast and J. Sjakste // Physical Review B. – 2011. - Vol. 84. – P. 035201.
8. Tyuterev V. Thermoelectric transport properties of silicon: Toward an ab initio approach / Zhao Wang, Shidong Wang, S. Obukhov et al. \Physical Review B. – 2011. - Vol. 83. – P. 205208.
9. Tyuterev V. Theoretical intrinsic lifetime limit of shallow donor states in silicon / V.Tyuterev, J. Sjakste, N. Vast // Physical Review B. – 2010. - Vol. 81. – P. 245212.

Научный руководитель

В.Г. Тютерев

Верно

Ученый секретарь ученого совета ТГПУ

10.08.2015г.



**Подпись удостоверяю**  
**ученый секретарь**  
**Ученого совета ТГПУ**

Н.И.Медюха